

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 16 年 8 月 26 日 (2004.8.26)

【公開番号】特開 2001-257374 (P2001-257374A)
 【公開日】平成 13 年 9 月 21 日 (2001.9.21)
 【出願番号】特願 2000-114399 (P2000-114399)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 31/04
 // C 0 1 B 31/02

【F I】

H 0 1 L 31/04 H
 H 0 1 L 31/04 E
 C 0 1 B 31/02 1 0 1 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 15 年 8 月 12 日 (2003.8.12)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

表面に電気絶縁層が形成されたカーボンフィルム基板と、前記電気絶縁層上に形成された下部電極層と、その下部電極層上に形成された p 型の C I S 系の光吸収層と、その光吸収層上に形成された n 型半導体層と、その n 型半導体層上に形成された上部透明電極層とをそなえたことを特徴とする太陽電池。

【請求項 2】

n 型半導体層と上部透明電極層との間に、高抵抗層が設けられていることを特徴とする請求項 1 の記載による太陽電池。

【請求項 3】

カーボンフィルム基板は、フィルム状に加工されたポリカルボジイミドを焼成することにより得られたものであることを特徴とする請求項 1 の記載による太陽電池。